

**SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED
HIGH EFFICIENCY SILICON RECTIFIER**
VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 2.0 Amperes

FEATURES

- * Glass passivated device
- * Ideal for surface mounted applications
- * Low leakage current
- * Metallurgically bonded construction
- * Mounting position: Any
- * Weight: 0.098 gram

MECHANICAL DATA

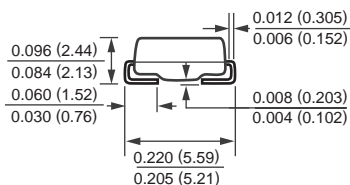
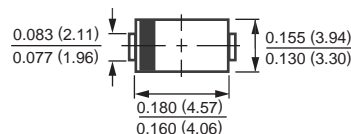
- * Epoxy : Device has UL flammability classification 94V-0

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.



DO-214AA



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	HFM201	HFM202	HFM203	HFM204	HFM205	HFM206	HFM207	HFM208	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	50	100	200	300	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Volts	VRMS	35	70	140	210	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	Vdc	50	100	200	300	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Current at TA = 55°C	Io	2.0								Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	60								Amps
Typical Junction Capacitance (Note 2)	Cj	30					20			pF
Operating and Storage Temperature Range	TJ, TSTG	-55 to + 150								°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

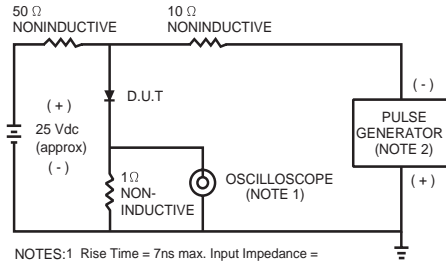
CHARACTERISTICS	SYMBOL	HFM201	HFM202	HFM203	HFM204	HFM205	HFM206	HFM207	HFM208	UNITS
Maximum Forward Voltage at 2.0A DC	Vf	1.0			1.3		1.7			Volts
Maximum Full Load Reverse Current, Full cycle Average TA = 55°C	Ir	50								uAmps
Maximum DC Reverse Current at @ TA = 25°C		5.0								uAmps
Rated DC Blocking Voltage @ TA = 125°C		100								uAmps
Maximum Reverse Recovery Time (Note 1)	trr	50					75			nSec

NOTES : 1. Test Conditions: IF=0.5A, IR=-1.0A, IRR=-0.25A.

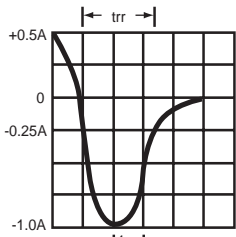
2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (HFM201 THRU HFM208)

FIG. 1 - TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC



NOTES: 1 Rise Time = 7ns max. Input Impedance = 1 megohm. 22pF.
2. Rise Time = 10ns max. Source Impedance = 50 ohms.



SET TIME BASE FOR 10/20 ns/cm

FIG. 2 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

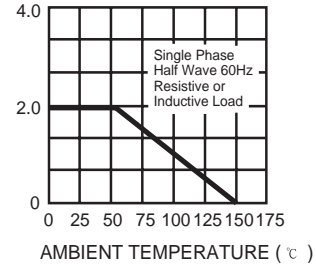


FIG. 3 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

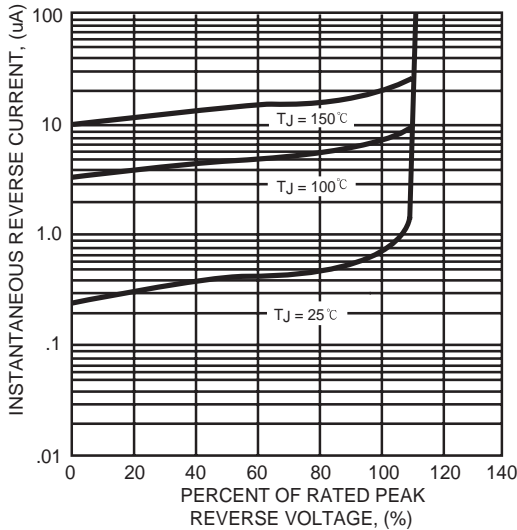


FIG. 4 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

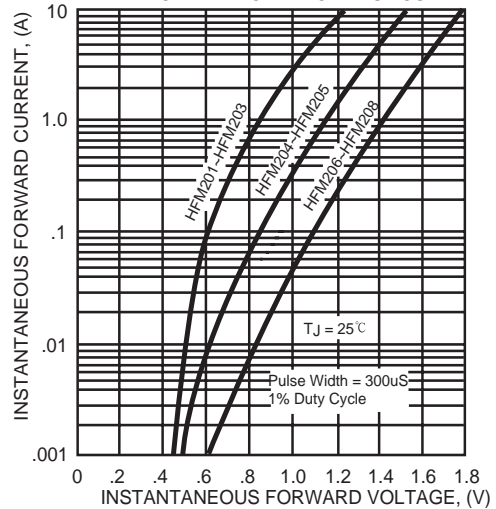


FIG. 5 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

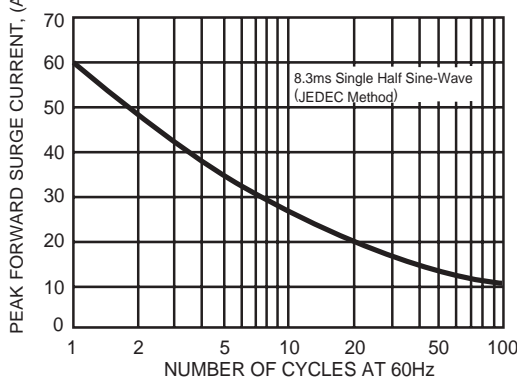
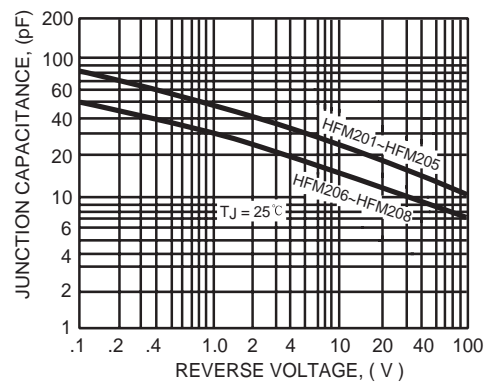
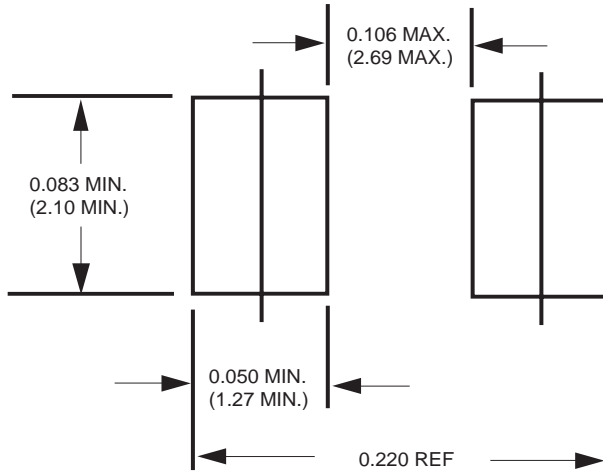


FIG. 6 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



Mounting Pad Layout



Dimensions in inches and (millimeters)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331